

	<h2 style="color: red;">TC58BYG2S0HBAI6</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TC58BYG2S0HBAI6
	Hersteller / Marke:	Toshiba Memory America, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
Datenblätter:	 TC58BYG2S0HBAI6.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 191 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TC58BYG2S0HBAI6
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	191 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Andere Namen	TC58BYG2S0HBAI6JDH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TC58BYG2S0HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BYG2S0HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BYG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TC58BYG2S0HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TC58C1287AXB(YDELA) TOSHIBA TC58C1287AXB(YDELA) TOSHIBA</p>	 <p>TC58BYG1S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p>TC58BYG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58C256AXB M-Syste TC58C256AXB M-Syste</p>
 <p>TC58C1286AXB TOSHIBA TC58C1286AXB TOSHIBA</p>	 <p>TC58BYG1S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 2GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE</p>	 <p>TC58BYG2S0HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p>TC58BYG0S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BYG2S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc.	TC58BYG2S0HBAI6 Datenblatt	TC58BYG2S0HBAI6-Datenblätter	TC58BYG2S0HBAI6 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TC58BYG2S0HBAI6
TC58BYG2S0HBAI6 Electronic	TC58BYG2S0HBAI6-Komponenten	TC58BYG2S0HBAI6-Verteiler	TC58BYG2S0HBAI6-Bild	TC58BYG2S0HBAI6-Teil
TC58BYG2S0HBAI6 Preis	TC58BYG2S0HBAI6 Hersteller	TC58BYG2S0HBAI6 Bild	TC58BYG2S0HBAI6 Aktie	TC58BYG2S0HBAI6 Inventar
TC58BYG2S0HBAI6 Neu	TC58BYG2S0HBAI6 Original	TC58BYG2S0HBAI6 garantiert	TC58BYG2S0HBAI6 RFQ	TC58BYG2S0HBAI6 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited